

UMT3N IMT3A

アイソレーテッドミニモールドデバイス
Isolated Mini-Mold Device
一般小信号増幅用/General Small Signal Amp.

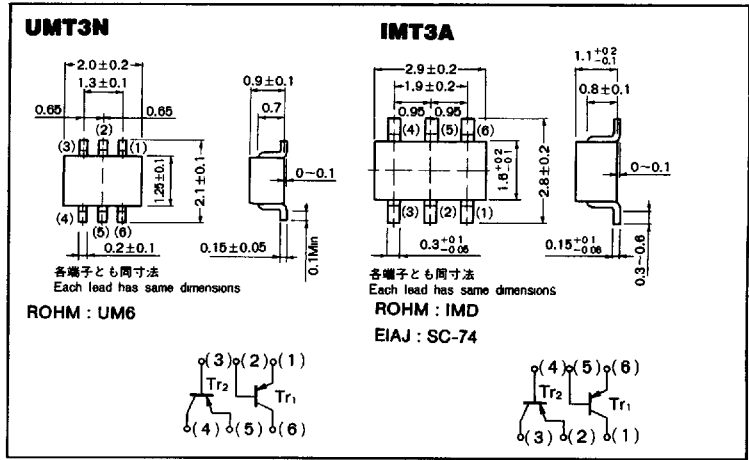
● 特長

- 1) UMT (SC-70), SMT (SC-59) と同一体積に 2 個のトランジスタが入っている。
- 2) UMT, SMT の自動装着機により、装着が可能である。
- 3) 各トランジスタの素子間は独立しているため相互干渉がない。

● Features

- 1) Two transistors are housed in the same volume as UMT (SC-70), SMT (SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of UMT, SMT can be used for mounting.
- 3) No mutual interference exists between each transistor.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



以下の特性は Tr₁, Tr₂ について共通です。/The following characteristics are common for Tr₁ and Tr₂.

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I _C	-100	mA
コレクタ損失	P _C	300 (TOTAL)*	mW
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150	°C

* ただし、1素子当り200mWをこえないこと。/ However, 200mW should not be exceeded per element.

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	-50	—	—	V	I _C =-50μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-40	—	—	V	I _C =-1mA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	-5	—	—	V	I _E =-50μA
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	—	—	-0.5	μA	V _{CB} =-30V
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	-0.5	μA	V _{EB} =-4V
直流電流増幅率	h _{FE}	120	—	—	—	V _{CE} /I _C =-6V/-1mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	—	-0.5	V	I _C /I _B =-50mA/-5mA

● 標準品・準標準品一覧表

(○：標準準品)

	包装名	テーピング					
	記号	TR	TL	TN	T108	T109	T110
Type	基本発注単位 (個)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
UMT3N		○	○	—	—	—	—
IMT3A		—	—	—	○	○	—

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

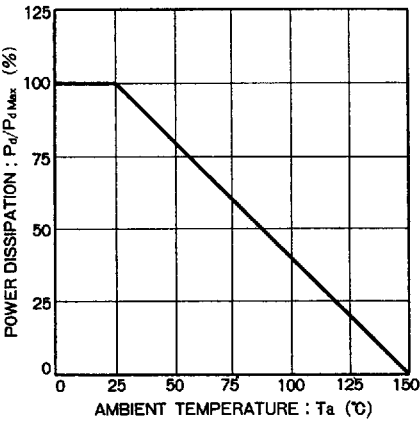


Fig.1 電力軽減曲線

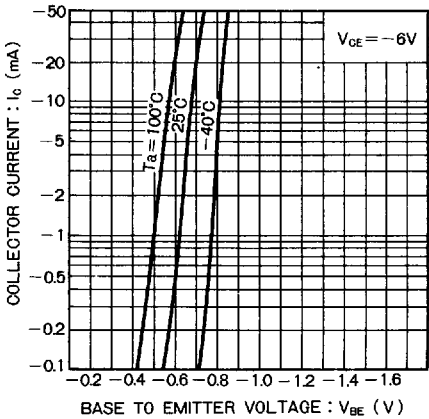


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

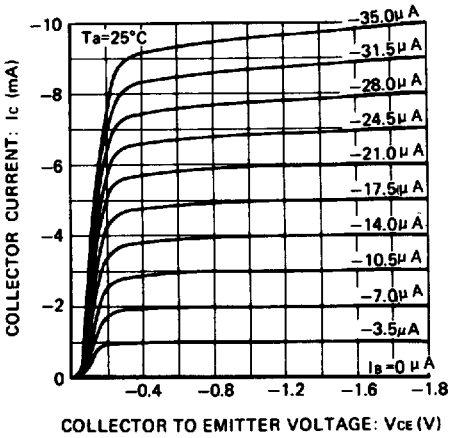


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

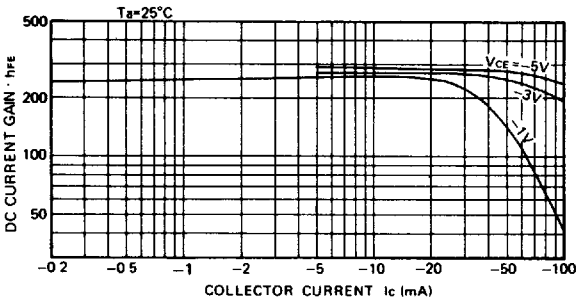


Fig.4 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

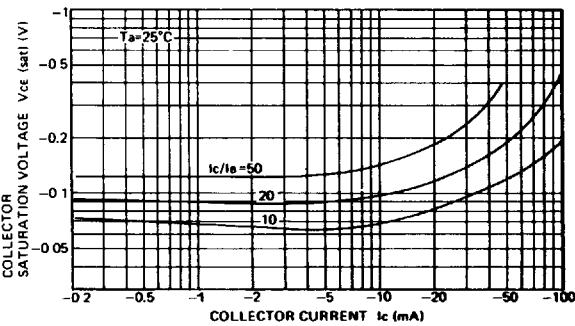


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

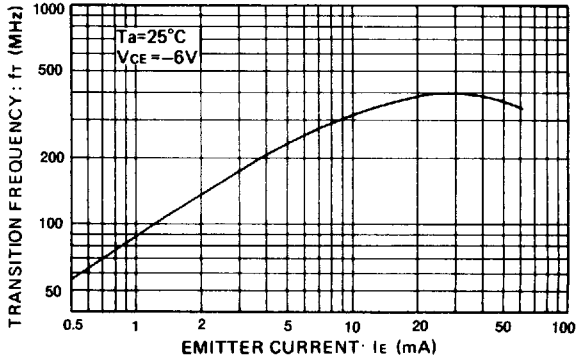


Fig.6 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

トランジスタ

2素子内蔵6端子タイプ

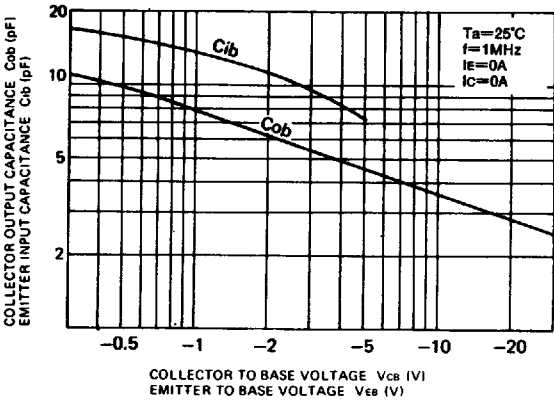


Fig.7 入出力容量—電圧特性